

Study of Low-Temperature Formation of Orientation-Controlled SiGe Crystals on Insulator by Gold-Induced Crystallization

朴, 鍾?

<https://doi.org/10.15017/1500747>

出版情報：九州大学, 2014, 博士（工学）, 課程博士
バージョン：
権利関係：全文ファイル公表済



氏 名	朴 鍾赫
論 文 名	Study of Low-Temperature Formation of Orientation-Controlled SiGe Crystals on Insulator by Gold-Induced Crystallization (金誘起成長法を用いた絶縁基板上における方位制御された SiGe 結晶の低温形成に関する研究)
論文調査委員	主査 九州大学 准教授 佐道 泰造 副査 九州大学 教授 浅野 種正 副査 九州大学大学院総合理工学研究院 教授 中島 寛

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

本研究は、絶縁膜上における SiGe の低温結晶成長プロセスについて詳細な検討を行い、フレキシブル・エレクトロニクスの高性能化に有用な結晶方位が制御された SiGe 結晶薄膜の低温成長プロセスの開発に成功したもので、電気電子工学上価値ある業績である。よって本論文は博士（工学）の学位に値するものと認める。